

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Einleitung</b>	<b>1</b>
1.1 Motivation . . . . .	1
1.2 Gliederung . . . . .	3
<b>2 Gruppe-III-Nitride: Grundlagen</b>	<b>5</b>
2.1 Kristallstruktur und Bandstruktur . . . . .	5
2.1.1 Kristallstruktur . . . . .	5
2.1.2 Bandstruktur . . . . .	8
2.2 Ternäre Verbindungen . . . . .	9
2.3 Verspannung und Polarisation . . . . .	10
2.3.1 Verspannung . . . . .	11
2.3.2 Polarisation . . . . .	13
2.4 Quantenfilme . . . . .	16
2.4.1 QCSE – Der „quantum confined Stark effect“ . . . . .	18
2.5 Typische Defekte . . . . .	20
2.5.1 Punkt- und Liniendefekte . . . . .	20
2.5.2 Flächendefekte . . . . .	22
2.5.3 Volumen- und Oberflächendefekte . . . . .	25
2.5.4 Lumineszenz von Defekten . . . . .	25
2.6 Die Substratproblematik . . . . .	27
2.7 Die „Grüne Lücke“ . . . . .	28
<b>3 Epitaxie</b>	<b>31</b>
3.1 Substrate für die GaN-Epitaxie . . . . .	31
3.1.1 Saphir . . . . .	32
3.1.2 Siliziumkarbid . . . . .	34
3.1.3 Silizium . . . . .	35
3.1.4 Sonstige . . . . .	36
3.2 Möglichkeiten der GaN-Herstellung . . . . .	37

3.2.1	MOVPE . . . . .	38
3.2.2	HVPE . . . . .	42
3.2.3	Wachstum von Volumenkristallen . . . . .	45
<b>4</b>	<b>Nichtpolares GaN</b>	<b>51</b>
4.1	Schichtwachstum mittels MOVPE . . . . .	51
4.1.1	Nukleationsschichten . . . . .	51
4.1.2	Einfache GaN-Schichten . . . . .	55
4.1.3	Mehrstufiges Wachstum und SiN-Zwischenschichten . . . . .	57
4.2	Mittels HVPE überwachsene Schichten . . . . .	63
4.2.1	Einfluss des MOVPE-Templates . . . . .	63
4.2.2	Optimierung der Wachstumsparameter . . . . .	64
4.2.3	Vergleich mit anderen Proben . . . . .	65
4.3	Fehlorientierte Substrate . . . . .	69
4.3.1	MOVPE-Schichten . . . . .	71
4.3.2	HVPE-Schichten . . . . .	72
4.4	Quantentopfproben mittels MOVPE . . . . .	75
4.4.1	Integrale Lumineszenz . . . . .	75
4.4.2	Oberflächendefekte - Pits . . . . .	76
4.4.3	Örtlich aufgelöste Untersuchungen . . . . .	77
4.5	Quantentopfproben auf HVPE-Templates . . . . .	80
<b>5</b>	<b>Semipolares GaN</b>	<b>83</b>
5.1	Die Idee . . . . .	83
5.2	Strukturierung der Substrate . . . . .	85
5.2.1	Reflexschicht . . . . .	86
5.2.2	Ätzprozess . . . . .	86
5.2.3	Optimierung der Ätzparameter . . . . .	89
5.2.4	Zusammenfassung . . . . .	91
5.3	(11-22)-orientierte Schichten . . . . .	94
5.3.1	Kristallorientierung . . . . .	94
5.3.2	Oberflächenmorphologie und Struktur . . . . .	97
5.3.3	Kristallqualität . . . . .	101
5.3.4	Ortsaufgelöste Messungen . . . . .	104
5.3.5	Quantentopfproben . . . . .	105
5.4	(10-11)-orientierte Schichten . . . . .	108
5.4.1	Verändertes Anwachsverhalten . . . . .	109

5.4.2	Optisches Erscheinungsbild . . . . .	111
5.4.3	Kristallorientierung und -qualität . . . . .	114
5.4.4	Quantentopfproben . . . . .	119
5.5	Weitere Orientierungen . . . . .	121
5.6	HVPE-Wachstum . . . . .	122
<b>6</b>	<b>Zusammenfassung</b>	<b>125</b>
	<b>Summary</b>	<b>129</b>
	<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>VII</b>
	<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>XI</b>
	<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>XIII</b>
<b>A</b>	<b>Anhang</b>	<b>XVII</b>
	<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>XIX</b>
	<b>Publikationsliste</b>	<b>XLIII</b>
	<b>Danksagung</b>	<b>XLIX</b>